

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 津田邦男 副委員長 須原理彦

幹事 東脇正高・大石敏之 幹事補佐 岩田達哉・小谷淳二

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 10月24日(水) 14:00~16:50

会場 機械振興会館地下3階1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線; 神谷町駅下車, 徒歩8分. <http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>)

議題 電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術

1. ボルケーノ構造スピント型エミッタアレイの動作チップ数の向上
新谷英世・○村田英一・池田貴大・六田英治・下山 宏(名城大)・長尾昌善・村上勝久(産総研)
2. 大電力パルススパッタ法によるスピント型陰極作製における放電ガス(アルゴン, クリプトン)の効果
○谷口日向・大家 溪・中野武雄(成蹊大)・長尾昌善・大崎 壽・村上勝久(産総研)
3. Pd酸化物を貴金属供給源に持つ貴金属被覆ナノ電子源の作製—Pd酸化物の還元処理の検討—
○浅井泰尊・川合亮太・松原史弥・田中崇之・村田英一・六田英治(名城大)
4. グラフェン形成によって誘起されたNi針先端の構造変化
○川合亮太・浅井泰尊・松原史弥・田中崇之・村田英一・六田英治(名城大)
5. アルカリ光電面を用いた超高速変調ビーム形成に関する基礎実験
○高橋隼斗・根尾陽一郎・細田 誠・三村秀典(静岡大)
6. 時間依存密度汎関数法によるカーボンナノチューブのエミッションパターンの計算
○樋口敏春・山田洋一・佐々木正洋(筑波大)

☆ED研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月29日(木), 30日(金) 名工大〔締切済〕テーマ: 窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般

2019年1月17日(木), 18日(金) 日立中研〔11月10日(土)〕テーマ: 化合物半導体IC及び超高速・超高周波デバイス/マイクロ波/一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<https://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

新井 学(新日本無線)

TEL [049] 278-1441, FAX [049] 278-1269

E-mail: marai@njr.co.jp

東脇正高(NICT)

TEL [042] 327-6092, FAX [042] 327-5527

E-mail: mhigashi@nict.go.jp